



บทที่ 2

การแปรรูปโลหะด้วยกรรมวิธีอีดีเอ็ม

2.1 หลักการเบื้องต้นของอีดีเอ็ม

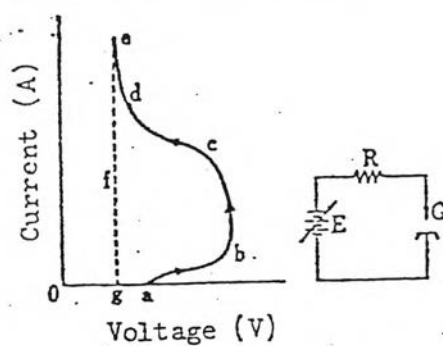
1. การเกิดคิสซาร์จ

กรรมวิธีอีดีเอ็ม เป็นกรรมวิธีซึ่งอาศัยพลังงานการเกิดการคิสซาร์จทางไฟฟ้า โดยใช้เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์ของการเกิดการคิสซาร์จทางไฟฟ้าตามธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักกันดีเป็นเวลานานแล้วก็คือ การเกิดฟ้าผ่า ส่วนในชีวิตประจำวัน ผลึกภัณฑ์บางอย่างที่คุ้นเคยกันดีก็อาศัยหลักการนี้เช่นเดียวกัน เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น

ตัวอย่างของการอธิบายการเกิดการคิสซาร์จเช่น เมื่อขั้วของอิเล็กโทรดสองขั้ว ซึ่งมีความต่างศักย์ไฟฟ้า ถูกนำมาไว้ในตัวกลางไฟฟ้า (dielectric) ซึ่งกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป และความต่างศักย์ไฟฟ้าของขั้วอิเล็กโทรดมีค่าถึงค่าหนึ่ง สภาพความเป็นฉนวนของตัวกลางเริ่มถูกทำลาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการคิสซาร์จ ดังในรูปที่ 2.1 ซึ่งแสดงถึงวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย และกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อน และกระแสไฟฟ้า ภายใต้สภาวะของการเกิดการคิสซาร์จ

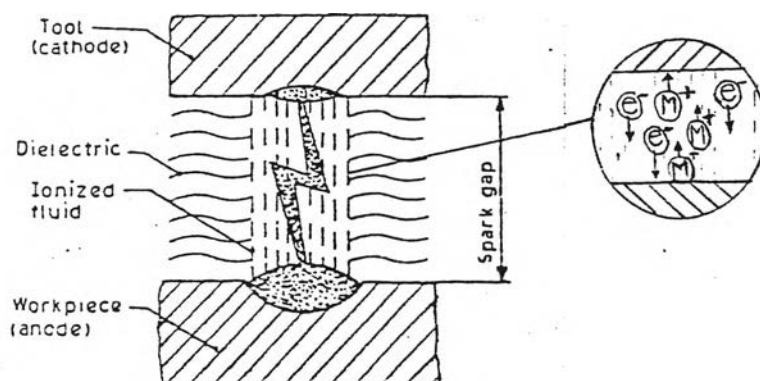
จากรูปที่ 2.1 เมื่อแหล่งจ่ายไฟ E ถูกต่อไว้กับขั้วอิเล็กโทรด G ซึ่งอยู่ในบรรยากาศ ผ่านความต้านทาน R ในขณะที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟมีค่าเพิ่มขึ้นตามลำดับ ก๊าซก็จะค่อย ๆ ถูกอ็อกซิไดส์ (ionize) โดยอนุภาคที่มีพลังงานสูงซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ (ตัวอย่างเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีอัลตราไวโอเล็ต) ซึ่งอาจอธิบายปรากฏการณ์นี้ตามลำดับได้ดังนี้คือ

- ช่วง a-b เริ่มมีการไหลของอนุภาคที่ถูกไอออไนซ์ตามการเพิ่มขึ้นของแรงเคลื่อนไฟฟ้า
- เนื่องจากแรงเคลื่อนระหว่างอิเล็กโทรดมีค่าเพิ่มขึ้นตามลำดับ จึงเกิดการคายประจุที่ไม่เสถียร (unstable discharge) ขึ้นที่จุด b ซึ่งเรียกว่า โครนาคายประจุ (corona discharge)
- ช่วง b-d เป็นสภาวะของสปาร์กคายประจุ (spark discharge) ขณะเดียวกันอนุภาคก็มีความเร็วเพิ่มขึ้น
- ช่วง d-e ซึ่งกระแสมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการคายประจุที่เสถียรซึ่งเรียกว่า อาร์คคายประจุ (arc discharge)

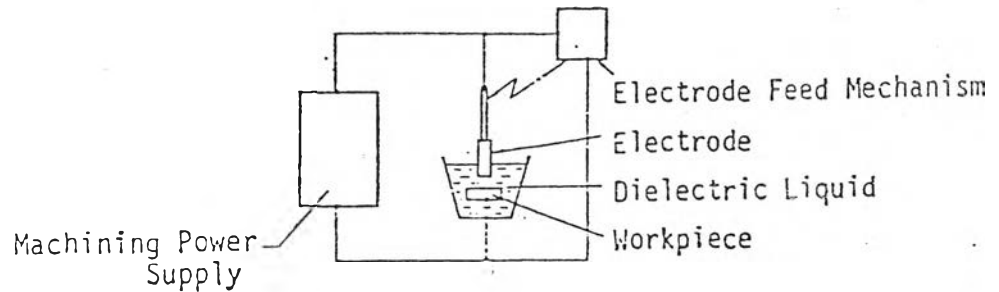


รูปที่ 2.1 แรงเคลื่อนและกระแสภายใต้สภาวะการเกิดคายประจุ

จากหลักการเบื้องต้นของการเกิดการดีสชาร์จ ซึ่งได้นำมาใช้กับกรรมวิธี อีดีเอ็ม กล่าวคือ เมื่อขั้วไฟฟ้าสองขั้วคือ ชิ้นงานและอิเล็กโทรดซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกัดชิ้นงาน (tool electrode) ซึ่งมักเรียกสั้น ๆ ว่าอิเล็กโทรด ได้ถูกนำมาไว้ตรงข้ามกันและให้มีช่องว่างระหว่างกันในของเหลวที่เรียกว่า ไดอิเล็กตริก (dielectric) ขณะเดียวกันพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้ถูกปล่อยอย่าง เป็นจังหวะหรือพัลส์ (pulse) จากแหล่งจ่ายไฟ ด้วยค่าของแรงเคลื่อนค่าหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดการดีสชาร์จขึ้นระหว่างช่องว่างของชิ้นงาน และอิเล็กโทรด ดังที่แสดงในรูปที่ 2.2 จากผลดังกล่าวทำให้ชิ้นงานได้ถูกหลอมละลายและกลายเป็นไอได้ กับทั้งมีบางส่วนซึ่งถูกทำให้ฟุ้งกระจายเนื่องจากผลของความดัน ซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วย และการไหลเวียนของตัวไดอิเล็กตริก ก็จะเป็นการพัดพาเอาเศษโลหะออกไปจากช่องว่างในชิ้นงาน เพื่อให้กรรมวิธีได้ดำเนินต่อไปได้ดำเนินต่อไปได้ และเนื่องจากการดีสชาร์จได้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กัน ช่องว่างระหว่างชิ้นงานและอิเล็กโทรดจึงกว้างขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกลไกที่จะควบคุมและป้อนอิเล็กโทรด ให้มีระยะช่องว่างกับชิ้นงานตามที่ต้องการ ดังรูปที่ 2.3 ซึ่งแสดงแผนภาพอย่างง่ายของอีดีเอ็ม



รูปที่ 2.2 หลักการเบื้องต้นของอีดีเอ็ม



รูปที่ 2.3 แผนภาพอย่างง่ายของอีดีเอ็ม

2. วงจรแหล่งจ่ายไฟ

อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของเครื่องอีดีเอ็มก็คือ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยวงจรทางไฟฟ้า ที่จะจ่ายกระแสผ่านอิเล็กโตรดและชิ้นงานอย่างเป็นจังหวะที่ต่อเนื่องกัน วงจรไฟฟ้าที่ใช้อาจจำแนกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบวงจรอาร์-ซี (R-C circuit) หรือ แบบวงจรรีแลกเซชัน (relaxation circuit) และแบบวงจรสร้างพัลส์ (pulse generator circuit)

-วงจรแบบอาร์-ซี

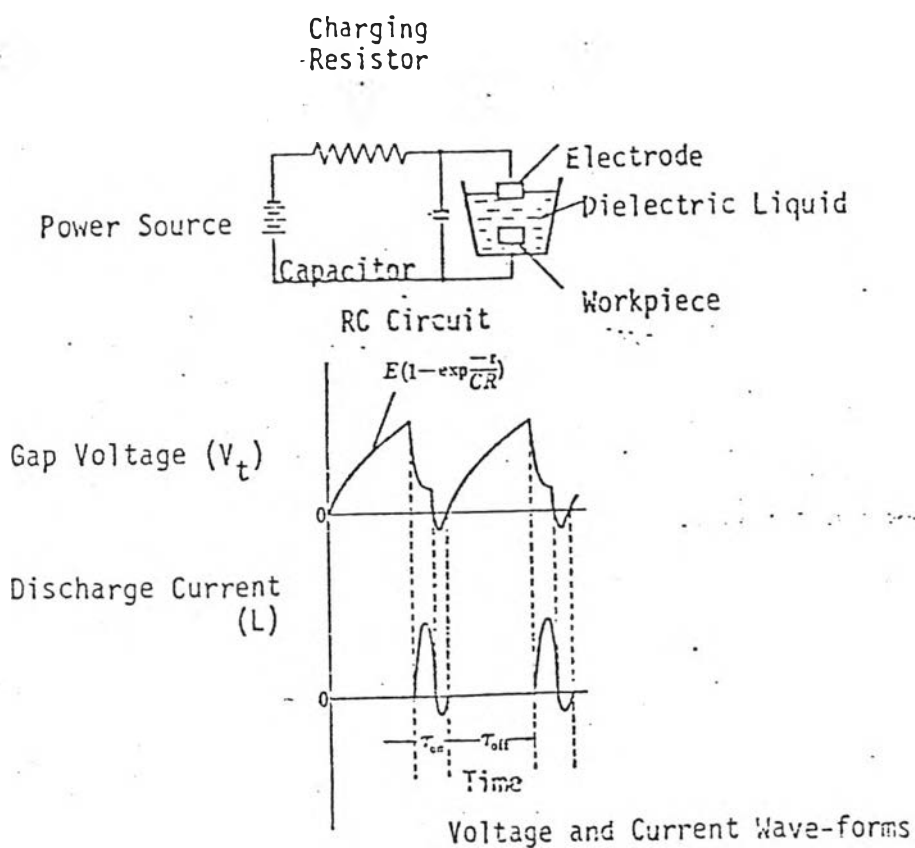
แบบพื้นฐานของวงจรชนิดนี้ดังที่แสดงในรูปที่ 2.4 ซึ่งประกอบด้วยตัวความต้านทาน, คาปาซิเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง และถ้ากำหนดว่าระยะห่างของอิเล็กโตรดกับชิ้นงานมีค่าคงที่แล้ว แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ช่องว่างของอิเล็กโตรด $V(t)$ สามารถแสดงได้ คือ

$$V(t) = E (1 - e^{-t/RC})$$

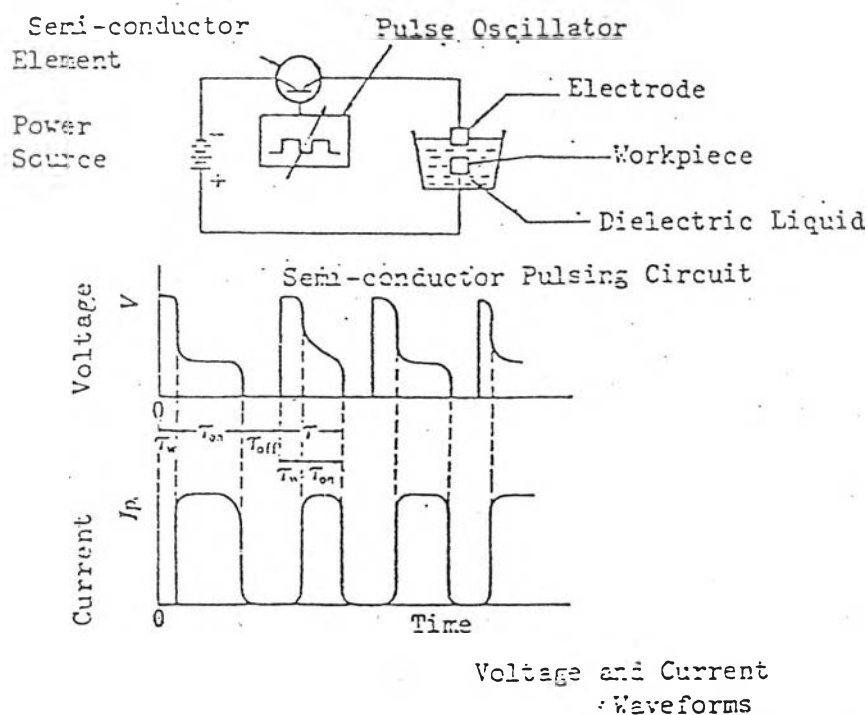
ซึ่งกราฟแสดงรูปคลื่นของแรงเคลื่อนและกระแสดังที่แสดงในรูปที่ 2.4

-วงจรแบบสร้างพัลส์

การพัฒนาอุปกรณ์จำพวกสารกึ่งตัวนำ เช่นทรานซิสเตอร์ ทำให้ได้มีการนำมาใช้ออกแบบวงจรแบบนี้ ซึ่งสามารถควบคุมรูปคลื่นของแรงเคลื่อนและกระแสได้ง่ายขึ้น ดังในรูปที่ 2.5 ซึ่งแสดงแบบวงจรพื้นฐาน พร้อมทั้งรูปคลื่นของแรงเคลื่อนและกระแส



รูปที่ 2.4 วงจรแบบอาร์-ซี

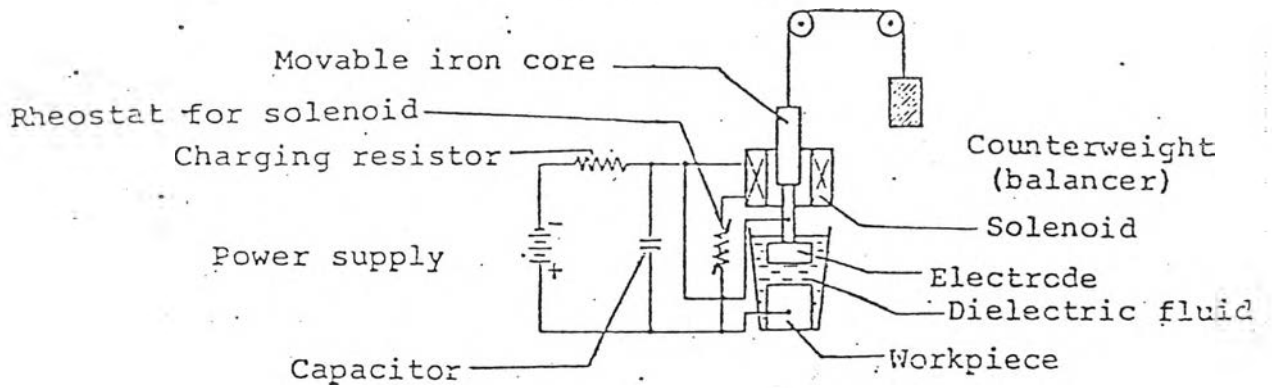


รูปที่ 2.5 วงจรแบบสร้างพัลส์

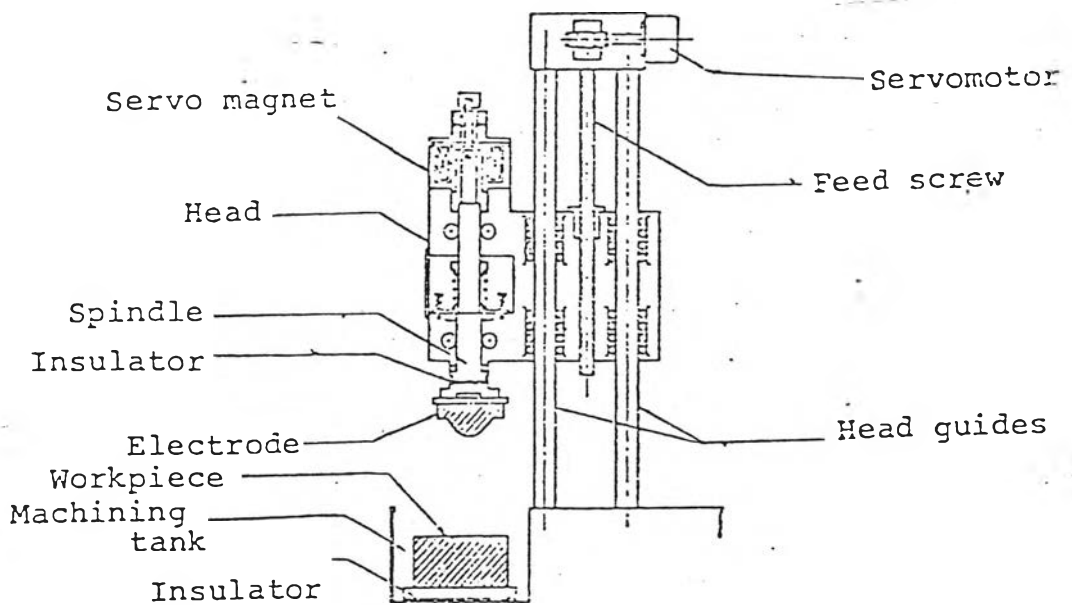
3. กลไกป้อนอิเล็กโตรด

กลไกป้อนอิเล็กโตรด เป็นตัวควบคุมระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างชิ้นงาน และอิเล็กโตรด ในขณะที่เดียวกันก็เป็นการควบคุมค่ากระแสแอสติสซาร์จระหว่างช่องว่างดังกล่าวตามที่กำหนด

ในระยะแรกเริ่มของการพัฒนากรรมวิธีอีดีเอ็มนั้น กลไกการควบคุมการป้อนของอิเล็กโตรดเป็นแบบที่ใช้คลาวด์โซลินอยด์ประกอบกับน้ำหนักถ่วง ดังในลักษณะที่แสดงในรูปที่ 2.6 ต่อมาได้พัฒนาโดยการนำระบบเซอร์โวมาใช้ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น ดังที่แสดงในรูปที่ 2.7 สำหรับระบบไฮดรอลิค ซึ่งได้นำมาใช้ร่วมกับระบบเซอร์โวนั้น เพื่อใช้กับงานใหญ่ ที่ต้องใช้อิเล็กโตรดซึ่งมีน้ำหนักมากโดยเฉพาะ



รูปที่ 2.6 กลไกป้อนน้ำอิเล็กโตรดแบบโซลินอยด์



รูปที่ 2.7 กลไกป้อนน้ำอิเล็กโตรดแบบเซอร์โว

4. สารไดอิเล็กตริก

การทำงานของอีดีเอ็มนั้น ปกติแล้วตัวอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นงานจะอยู่ในถังของเหลวซึ่งเรียกว่า ไดอิเล็กตริก (dielectric fluid) ซึ่งมีหน้าที่ระบายความร้อน, เป็นฉนวนระหว่างตัวอิเล็กทรอนิกส์กับชิ้นงาน และเป็นตัวทำความสะอาดที่จะพัดพาเอาเศษโลหะ และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานออกจากชิ้นงาน

ลักษณะที่พึงประสงค์ของของเหลวที่จะใช้เป็นไดอิเล็กตริก คือ

- มีความหนืดต่ำ
- มีจุดติดไฟสูง และไม่ระเหยเป็นไอได้ง่าย
- มีสภาพความเป็นฉนวนสูง
- มีความสามารถในการระบายความร้อนได้ดี
- ไม่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนชิ้นงานและตัวอิเล็กทรอนิกส์
- ไม่เป็นสารพิษ และมีควันหรือไอ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
- มีราคาต่ำและหาซื้อได้ง่าย

สารที่อาจใช้เป็นไดอิเล็กตริกมีหลายชนิด เช่น น้ำบริสุทธิ์, น้ำมันก๊าด, และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ได้มีบริษัทผู้ผลิตของเหลวเพื่อใช้เป็นสารไดอิเล็กตริกโดยเฉพาะ

5. ตัวอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอิเล็กทรอนิกส์ คือวัสดุที่ใช้เป็นตัวแม่แบบที่จะทำให้ชิ้นงานเกิดการกัดเซาะเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ ในทางทฤษฎีแล้วตัวอิเล็กทรอนิกส์จะใช้วัสดุชนิดใดก็ได้ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามวัสดุที่จะนำมาเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์นั้นควรจะ ต้องสามารถแปรรูปได้ง่ายและมีอัตราการสึกหรอเนื่องจากการดิสชาร์จต่ำ

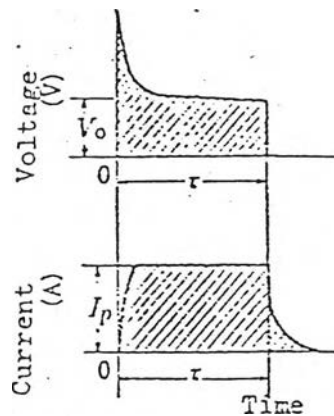
ปัจจุบันวัสดุที่ใช้เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็นได้ทั้งโลหะ, อโลหะ เช่น ทองแดง, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, โลหะผสม และกราไฟต์ เป็นต้น

6. พลังงานคิสชาร์จ (Discharge Energy)

ถ้าพิจารณาจากแต่ละพัลส์ของการคิสชาร์จ (single pulse discharge) แล้ว โดยทั่วไปแรงเคลื่อนคิสชาร์จ (discharge voltage) และ กระแสคิสชาร์จ (discharge current) ในระหว่างช่องว่างคิสชาร์จ (discharge gap) สามารถเขียนได้ดังที่แสดงในรูปที่ 2.8 และพลังงานคิสชาร์จ J_0 สามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้คือ

$$J_0 = \int_0^{t_i} V(t) i(t) dt$$

- เมื่อ
- J_0 = พลังงานคิสชาร์จ (J)
 - t_i = เวลาคิสชาร์จ (μs)
 - $V(t)$ = แรงเคลื่อนคิสชาร์จ (V)
 - $i(t)$ = กระแสคิสชาร์จ (A)



รูปที่ 2.8 รูปคลื่นของแรงเคลื่อนคิสชาร์จและกระแสคิสชาร์จ

จากรูปที่ 2.8 จะเห็นว่าแรงเคลื่อนคิสซาร์จและกระแสคิสซาร์จมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตอนเริ่มต้นของการคิสซาร์จ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ช่องว่างคิสซาร์จมีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในช่วงที่มีการสูญเสียสภาพความเป็นฉนวน (breakdown) ของไดโอดีล็คทริก ซึ่งเป็นช่วงเวลานั้น ๆ ประมาณ 10^{-7} ถึง 10^{-6} วินาที ซึ่งแรงเคลื่อนมีค่าลดลง ในขณะที่กระแสมีค่าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามค่าของกระแสในระหว่างช่วงของพัลส์แต่ละช่วงจะไม่เป็นศูนย์ในทันทีทันใดแต่จะใช้เวลาประมาณ 0.5 ถึง 1 μs ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์ประกอบของสวิทช์ซึ่งเซมิคอนดัคเตอร์ (switching semiconductor) ในวงจรที่สร้างพัลส์

เนื่องจากการเปลี่ยนลักษณะของรูปคลื่น ในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดของการคิสซาร์จจะถือว่ามีค่าน้อย ๆ ดังนั้นทั้งรูปคลื่นของแรงเคลื่อน และกระแสจึงอาจถือได้ว่า มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และพลังงานคิสซาร์จจึงอาจเขียนได้เป็น

$$J_0 = V \cdot I_p \cdot t_i$$

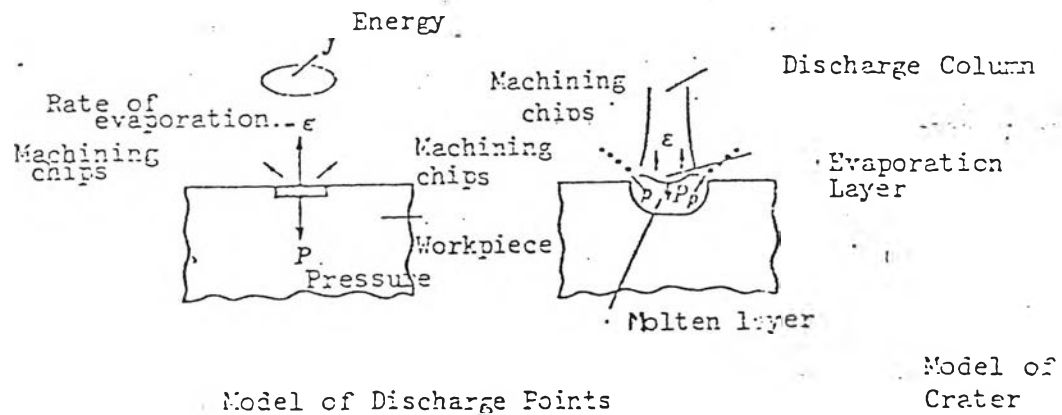
นั่นคือ

$$J_0 \propto I_p \cdot t_i$$

7. ผิวงานของอีดีเอ็ม

ผิวงานที่ได้จากการกัดด้วยวิธีอีดีเอ็ม จะมีลักษณะที่ประกอบไปด้วยหลุมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า เครเตอร์ (crater) ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อของโลหะได้ถูกกัดเซาะออกไป

ในตอนเริ่มต้นของการคิสซาร์จนั้น จะเกิดสนามไฟฟ้าสถิตย์ที่มีความเข้มสูงจากนั้นกลุ่มอนุภาคก็จะกลายเป็นไอด้วยอัตรา ϵ และถูกทำกระจายด้วยพลังงาน J ซึ่งทำให้เกิดความดันปฏิกิริยา P ดังที่แสดงในรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 การเกิดเครเตอร์

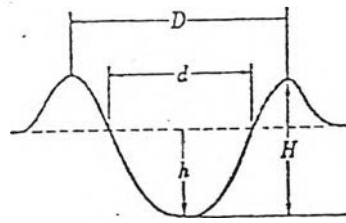
อย่างไรก็ตามการเกิดเครเตอร์ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ

(10)

1. ขั้นตอนเริ่มต้น (initiation and breakdown)
2. ขั้นตอนการดีสชาร์จ (discharge)
3. ขั้นตอนการกัดเซาะ (erosion)

ในขั้นตอนแรกอาจมีการกัดเซาะโลหะบ้าง เนื่องจากผลของแรงทางไฟฟ้าสถิตย์แต่ก็มีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณเนื้อโลหะที่ถูกกัดเซาะออกทั้งหมด เนื้อโลหะของเครเตอร์ที่ถูกกัดเซาะออกส่วนใหญ่ จะเนื่องมาจากในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งความดันที่เกิดขึ้นจะทำให้เนื้อโลหะที่หลอมละลาย และบางส่วนซึ่งกลายเป็นไอได้ถูกพัดพาออกไปจากผิวของชิ้นงาน ซึ่งพบว่าประมาณ 10 - 15 % ของโลหะที่หลอมละลายทั้งหมดได้ถูกพัดพาออกไป ส่วนที่เหลือก็จะกลับแข็งตัวใหม่

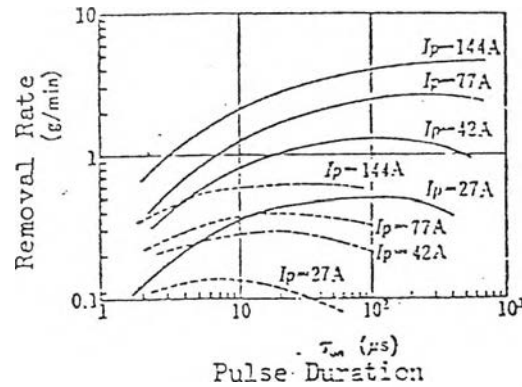
ลักษณะของ เครื่องเคอร์ที่เกิดจากการดิสชาร์จ 1 ครั้ง อาจแสดงเป็นแผนภาพอย่างง่ายได้ดังในรูปที่ 2.10 ซึ่งระยะ h คือความลึกของ เครื่องเคอร์จากผิวเดิมของชิ้นงาน (แนวเส้นประ) ส่วนที่นูนขึ้นที่บริเวณรอบ ๆ ขอบของ เครื่องเคอร์เกิดจากเนื้อโลหะที่กลับแข็งตัวใหม่



รูปที่ 2.10 ลักษณะของ เครื่องเคอร์

8. อัตราการกัด (Removal Rate)

ผลที่ต้องการจากการทำงานของอีดีเอ็ม ประการหนึ่งก็คือ การให้มีอัตราการกัดสูงสุด อัตราการกัดอาจวัดได้โดยปริมาณเนื้อโลหะของชิ้นงานที่ถูกกัดออกต่อหน่วยเวลา เช่น $g/min.$, $mm^3/min.$ เป็นต้น องค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่ออัตราการกัดก็คือ พลังงานดิสชาร์จ, วัสดุที่ใช้เป็นชิ้นงานและอิเล็กโทรด และการกำจัดเศษ เป็นต้น วิธีการที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มอัตราการกัดก็คือการเพิ่มค่ากระแส แต่ในขณะเดียวกัน อัตราการกัดที่สูงขึ้น ก็มีผลต่อความหยาบของผิวงานที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับค่ากระแสค่าหนึ่ง ๆ การเลือกค่าระยะพัลส์ (pulse duration) ที่เหมาะสม ก็จะทำให้ค่าอัตราการกัดที่สูงสุดได้ เช่น จากการใช้วัสดุชิ้นงานเป็นเหล็ก S55C และ WC(G2) โดยการใช้ทองแดงเป็นอิเล็กโทรด สามารถเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของอัตราการกัดกับระยะพัลส์ได้ ดังในรูปที่ 2.11 (3) นอกจากนี้ได้มีหลายการทดลองที่ได้พยายามหาอัตราการกัดภายใต้สภาวะการทำงานต่าง ๆ กัน (6,7,9)



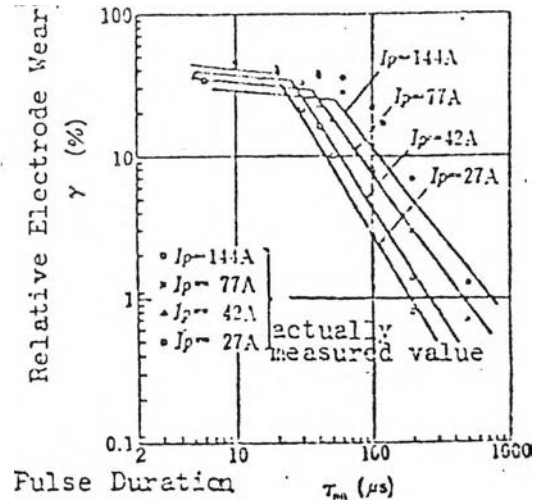
Solid line: Electrode Cu +, Workpiece: S 55 C
 Dotted line: Electrode Cu -, Workpiece: WC (G2)

รูปที่ 2.11 อัตราการกัดของวัสดุชิ้นงานและกระแสที่ระยะพัลส์ต่าง ๆ

9. อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรด

การพิจารณาอัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรด ก็เช่นเดียวกับการพิจารณาอัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรด ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรด เช่น พลังงานดิสชาร์จ, ชนิดของวัสดุอิเล็กโทรด และสถานะของสารไดอิเล็กตริก เป็นต้น อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดอาจวัดได้โดยปริมาณการสึกหรอต่อหน่วยเวลา หรืออาจวัดเป็นอัตราการสึกหรอสัมพัทธ์ โดยการเปรียบเทียบการสึกหรอของชิ้นงาน ปัจจุบันพบว่าการใช้ทองแดงและกราไฟต์ เป็นวัสดุอิเล็กโทรดสามารถให้อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดต่ำได้ โดยการกำหนดสถานะการทำงานให้ระยะพัลส์มีค่าสูง ๆ และกระแสต่ำ ๆ พร้อมทั้งกลับขั้วของอิเล็กโทรดและชิ้นงาน (ให้ชิ้นงานเป็นขั้วลบ และอิเล็กโทรดเป็นขั้วบวก)

จากการทดลองโดยใช้วัสดุชิ้นงานเป็นเหล็กกล้า S55C และใช้ทองแดงเป็นอิเล็กโทรด สามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสึกหรอสัมพัทธ์กับระยะพัลส์ ที่ค่ากระแสต่าง ๆ ได้ดังรูปที่ 2.12 (3)



รูปที่ 2.12 อัตราการสึกหรอสัมพัทธ์ของอิเล็กโทรดกับระยะพัลส์

2.2 การสร้างแบบจำลองสำหรับออดีเอ็ม

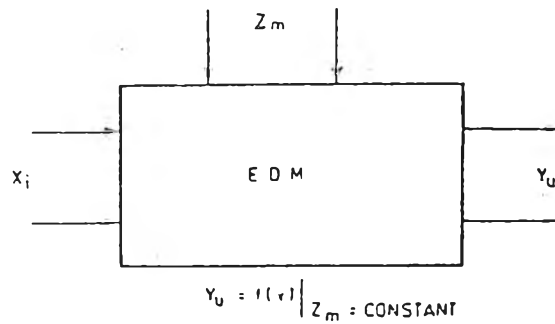
เนื่องจากกรรมวิธีออดีเอ็ม เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้น การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แทน จึงอาจทำได้โดยการเก็บข้อมูลค่าของ ตัวแปรที่ถือว่ามามีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากกรรมวิธี เพื่อนำมาสร้างเป็นความสัมพันธ์ ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจแสดงได้โดยแผนภาพ ดังรูปที่ 2.13

จากรูปที่ 2.13 จะเห็นว่า

X_i คือ ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดค่าให้เป็นตัวแปรซึ่งมีผลต่อออดีเอ็ม

Z_m คือ องค์ประกอบที่กำหนดค่าให้คงที่ตลอดการทดลอง

Y_u คือ ค่าที่วัดได้จากการทดลองหรือที่เรียกว่า ตัวแปรตอบสนอง
(response variable)



รูปที่ 2.13 การสร้างแบบจำลองสำหรับ อีดีเอ็ม

วิธีการทางสถิติที่นิยมมาใช้ในการสร้างสมการ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของตัวแปร ก็คือการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ในหลายการทดลองพบว่ากรรมวิธีอีดีเอ็ม อาจแทนได้ด้วย สมการพหุนามเมียบลอันดับที่สอง (7,9) ซึ่งมีรูปแบบทั่วไป คือ

$$Y_u = b_0 + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{i=1}^k b_{ii} x_i^2 + \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j$$

ซึ่งสมการประกอบด้วยพจน์ของ linear effect, quadratic effect และ interaction effect และสัมประสิทธิ์ของการถดถอย b_0 , b_i , b_{ii} และ b_{ij} อาจประมาณค่าได้โดยวิธีการกำลังสองน้อยที่สุด (least square method)

เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการทดลองซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระสองตัว ดังนั้นสมการจึงอาจเขียนได้เป็น

$$Y_u = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_{11} x_1^2 + b_{22} x_2^2 + b_{12} x_1 x_2$$

2.3 แบบจำลองสำหรับสภาวะที่เหมาะสม

การพิจารณาสภาวะที่เหมาะสม (optimum condition) จะพิจารณาโดยกำหนดฟังก์ชันเป้าหมาย (objective function) เป็น 2 กรณีคือ

กรณีที่ 1 ให้เวลาการกัณฑ์ต่ำที่สุด

ฟังก์ชันเป้าหมาย

$$\begin{aligned} \text{Minimize } T_t &= T_r + T_f \\ &= (m_r / m_{wr}) + (m_f / m_{wf}) \end{aligned}$$

$$m_{wr} = f(I_r, t_{ir})$$

$$m_{wf} = f(I_f, t_{if})$$

กรณีที่ 2 ให้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

ฟังก์ชันเป้าหมาย

$$\text{Minimize } C_t = C_o + C_w + C_e$$

$$C_o = k \cdot T_t / 60$$

$$C_w = (E_r \cdot C_{wr} + E_f \cdot C_{wf})$$

$$E_r = e_{wr} \cdot T_r$$

$$E_f = e_{wf} \cdot T_f$$

$$e_{wr} = f(I_r, t_{ir})$$

$$e_{wf} = f(I_f, t_{if})$$

$$C_e = C_{er} + C_{ef}$$

เงื่อนไขข้อช่วย

1. ข้อจำกัดของเครื่องจักร

$$I_{min} \leq I_r \leq I_{max}$$

$$I_{min} \leq I_f \leq I_{max}$$

$$t_{imin} \leq t_{ir} \leq t_{imax}$$

$$t_{imin} \leq t_{if} \leq t_{imax}$$

2. ข้อกำหนดของงาน

$$R_{t f} \leq \text{ค่าที่กำหนด}$$

สัญลักษณ์

$$T_t = \text{เวลารวมที่ใช้ในการกัดชิ้นงาน (min.)}$$

$$T_r = \text{เวลาที่ใช้กัดหยาบ (min.)}$$

$$T_f = \text{เวลาที่ใช้กัดละเอียด (min.)}$$

$$m = \text{ปริมาณของชิ้นงานที่ต้องกัด (g)}$$

$$m_r = \text{ปริมาณที่กัดหยาบ (g)}$$

$$m_f = \text{ปริมาณที่กัดละเอียด (g)}$$

$$m_w = \text{อัตราการกัด (g/min.)}$$

$$m_{w r} = \text{อัตราการกัดหยาบ (g/min.)}$$

$$m_{w f} = \text{อัตราการกัดละเอียด (g/min.)}$$

$$E_t = \text{ปริมาณการสึกหรอของอิเล็กโทรด (g)}$$

$$E_r = \text{การสึกหรอของอิเล็กโทรดในช่วงกัดหยาบ (g)}$$

$$E_f = \text{การสึกหรอของอิเล็กโทรดในช่วงกัดละเอียด (g)}$$

$$e_w = \text{อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรด (g/min.)}$$

$$e_{w r} = \text{อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดในช่วงกัดหยาบ (g/min.)}$$

$$e_{w f} = \text{อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดในช่วงกัดละเอียด (g/min.)}$$

$$I = \text{กระแส (A)}$$

$$I_r = \text{กระแสกัดหยาบ (A)}$$

$$I_f = \text{กระแสกัดละเอียด (A)}$$

$$I_{\min} = \text{กระแสต่ำสุดที่เครื่องจักรปรับได้ (A)}$$

$$I_{\max} = \text{กระแสสูงสุดที่เครื่องจักรปรับได้ (A)}$$

$$t_i = \text{ระยะพัลส์ (\mu s)}$$

$$t_{ir} = \text{ระยะพัลส์ในช่วงกัดหยาบ (\mu s)}$$

- t_{if} = ระยะเวลาพัลส์ในช่วงกักละเอียด (μs)
 t_{imin} = ระยะเวลาพัลส์ต่ำสุดที่เครื่องจักรปรับได้ (μs)
 t_{imax} = ระยะเวลาพัลส์สูงสุดที่เครื่องจักรปรับได้ (μs)
 C_t = ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)
 C_o = ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการทำงานของเครื่องจักร (บาท)
 k = อัตราค่าใช้จ่ายของเครื่องจักร (บาท/ชม.)
 C_w = ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสึกหรอของอิเล็กทรอนิกส์ (บาท)
 c_{wr} = ค่าใช้จ่ายจากการสึกหรอของอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกักหนายาบ (บาท/g)
 c_{wf} = ค่าใช้จ่ายจากการสึกหรอของอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกักละเอียด (บาท/g)
 C_e = ค่าอิเล็กทรอนิกส์ (บาท)
 c_{er} = ค่าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกักหนายาบ (บาท)
 c_{ef} = ค่าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกักละเอียด (บาท)

จากฟังก์ชันเป้าหมายในกรณีที่ 1 เมื่อต้องการให้เวลากักต่ำที่สุด ถ้ากำหนดปริมาณเนื้อโลหะ ที่ต้องกักในช่วงการกักหนายาบและการกักละเอียด ำให้แล้ว ดังนั้นฟังก์ชันเป้าหมายในกรณีนี้ก็ คือ การให้อัตราการกักสูงสุดนั่นเอง ฟังก์ชันเป้าหมายในกรณีนี้จึงอาจเขียนได้เป็น

$$\text{Maximize } m_w = f(I, t_i)$$

สำหรับในกรณีที่ลอง จากฟังก์ชันเป้าหมาย ที่ต้องการให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด จะเห็นว่าค่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นค่าคงที่ ส่วนค่าใช้จ่ายเนื่องจากการทำงานจะต่ำสุดก็ต่อเมื่ออัตราการกักสูงสุด และค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสึกหรอของอิเล็กทรอนิกส์จะต่ำที่สุด ก็คืออัตราการสึกหรอของอิเล็กทรอนิกส์ต่ำที่สุด ดังนั้นค่าใช้จ่ายรวมจะต่ำที่สุด เมื่ออัตราส่วนของอัตราการกักต่ออัตราการสึกหรอของอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด ฟังก์ชันเป้าหมายในกรณีนี้จึงอาจเขียนได้เป็น

$$\text{Maximize } m_w/e_w = f(I, t_i)$$